

M3FE40

400V 3A

特長

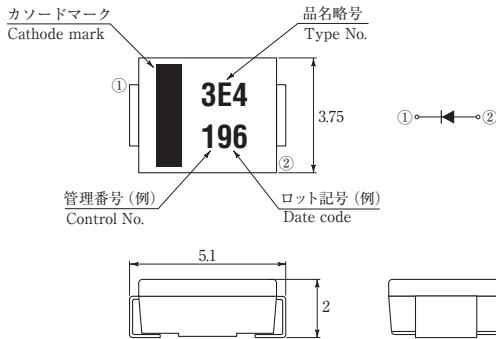
- ・小型 SMD
- ・耐湿性に優れ高信頼性
- ・静電気耐性に優れている

Feature

- Small SMD
- High-Reliability
- High ESD Capability

■外観図 OUTLINE

Package : M2F

Unit : mm
Weight : 0.072g(typ.)

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合は $T_{fl}=25^{\circ}\text{C}$ / unless otherwise specified)

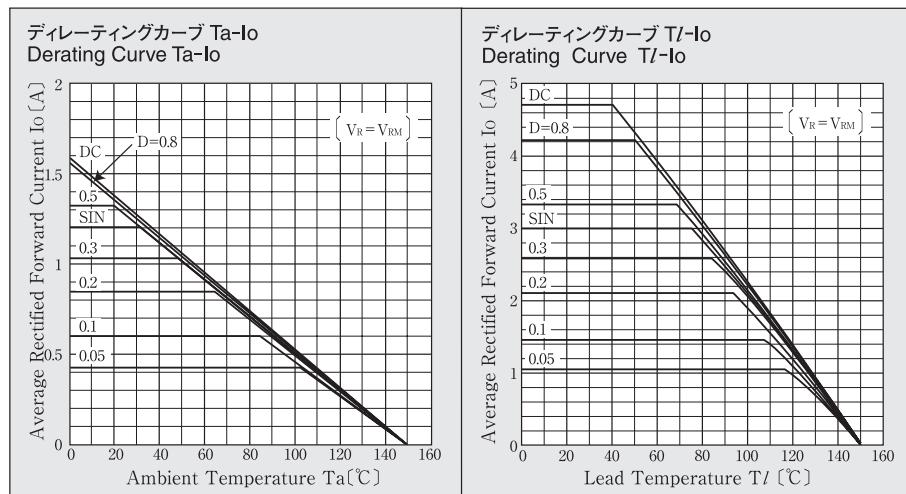
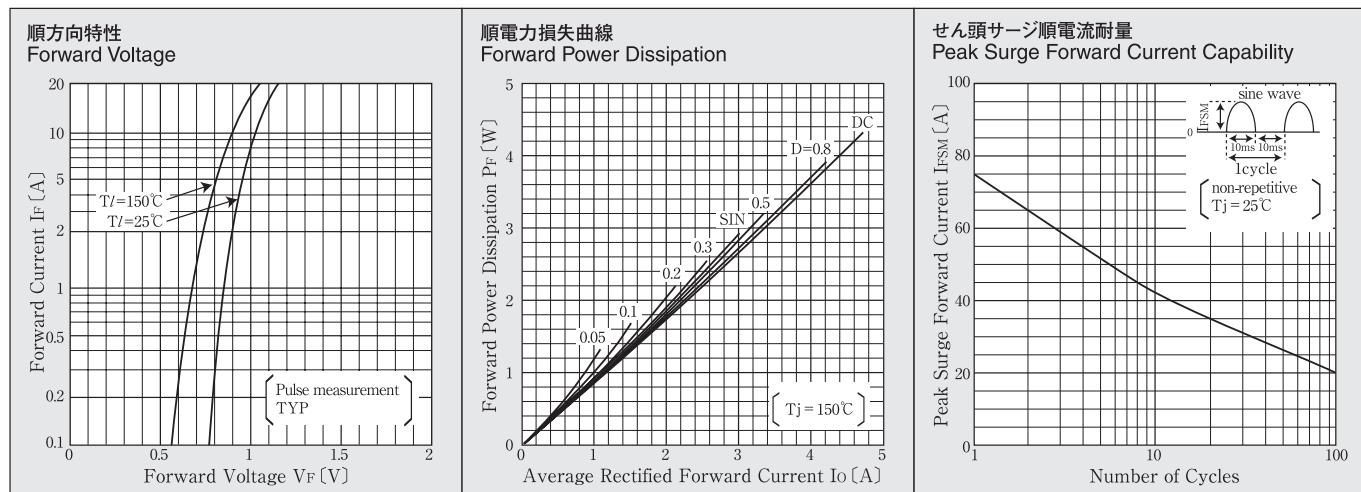
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	M3FE40	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	T _j			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			400	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	T _{fl} =76°C プリント基板実装 On glass-epoxy substrate T _a =32°C	3 1.2	A
せん頭サーボ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1サイクルせん頭値, T _j =25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, T _j =25°C		75	A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I ² t	1ms≤t<10ms, T _c =25°C		28	A ² s

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合は $T_{fl}=25^{\circ}\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _f =3A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 1.1	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R =400V, パルス測定 Pulse measurement	MAX 10	μA
静電気耐性 Electrostatic Discharge Capability	V _{ESD}	C=150pF, R=150Ω 極性±, 気中放電 *1 Polarity±, Aerial discharge *1	TYP 30	kV
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jl}	接合部・リード間, プリント基板実装 Junction to Lead, On epoxy-glass substrate	MAX 25	°C/W
	θ _{ja}	接合部・周囲間, プリント基板実装 Junction to Ambient, On epoxy-glass substrate	MAX 110	
	θ _{jc}	接合部・ケース間, プリント基板実装 Junction to Case, On epoxy-glass substrate	MAX 25	

*1 : IEC-61000-4-2規定に準拠
It is based on IEC-61000-4-2.

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine wave は 50Hz で測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
 Typical は統計的な実力を表しています。
 * Semiconductor products generally have characteristic variation.
 Typical is a statistical average of the device's ability.